1.42mm Silicon PD Chip datasheet

P/N：WS56-01B

Application

Si PIN photodiode chips

Structure

Planar type：PIN diode

Electrodes ：

Top side（Cathode）: Al

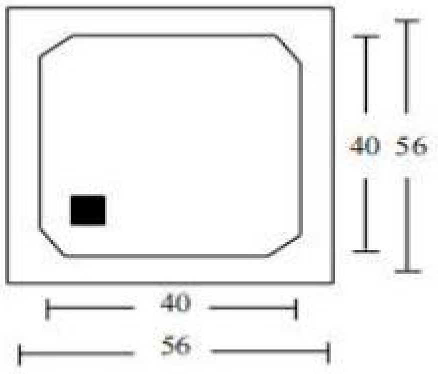
Backside（Anode） : Au Alloy

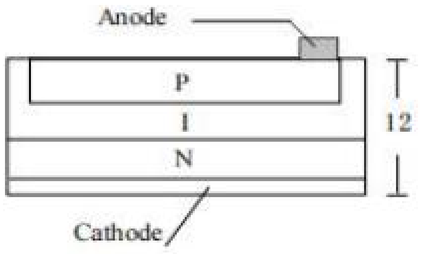
DIMENSIONS

Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
Active	40 ×40			mil
Chip width	56 × 56 （± 1.0）			mil
Chip length	56× 56 （± 1.0）			mil
Chip height	12 （±1.0）			mil
Pad N(Cathode)	6.4 ×6.4			mil
Pad P(Anode)	6.4 ×6.4			mil

Electro-Optical Characteristics（@ Ta=25 ℃)

Parameter	Symbol	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward Voltage	VF	IF=10mA, H=0	0.5		1.3	V
Reverse Voltage	VBR	IR=100μA, H=0	35			V
Reverse Dark Current	ID	VR=10V, H=0			10	nA
Sensitive Wavelength Range	λp			940		nm
Capacitance	CJ	VR=3V, F=1 MHz		11		pF





Unit : mil

WiNG CHiP 武汉万赢半导体科技有限公司
WUHAN WING CHIP SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY Co.,LTD.